PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

64-016853

(43) Date of publication of application: 20.01.1989

(51)Int.CI.

CO8L 27/16 CO8K 5/00

(21)Application number: 62-171116

(71)Applicant: RIKAGAKU KENKYUSHO

RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

10.07.1987

(72)Inventor: DATE MUNEHIRO

FURUKAWA TAKEO YAMAGUCHI TAKEO

UJIIE KOJI

(54) INCREASE OF PYROELECTRIC CURRENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a polymer increased in pyroelectric current on light irradiation, suitable for ferroelectric polymer optical memory etc., by dispersing a coloring matter in a vinylidene polymer to enhance light absorption thermal conversion efficiency.

CONSTITUTION: The objective polymer of increased pyroelectric current can be obtained by dispersing (A) a vinylidene polymer (e.g., polyvinylidene fluoride, polyvinylidene cyanide) with (B) such a coloring matter as to enhance light absorption thermal conversion efficiency (e.g., cyanine-based one).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

の日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-16853

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

昭和64年(1989)1月20日 ❸公開

27/16 C 08 L C 08 K 5/00

KJH

6845 - 4J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

の発明の名称

焦電電流の増加方法

牽

②特 頭 昭62-171116

昭62(1987)7月10日 펦 ❷出

位発 明 者 伊

宏 宗

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

古 Ш 明 者 砂発

夫 猛

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

73発 明 者 Щ

男 岡

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

趓 家 ②発 明 渚 Œ. 理化学研究所 ①出 顋 人

埼玉県和光市広沢2番1号

株式会社リコー の出 顋 人

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

弁理士 小松 秀岳 図代 理 人

外2名

明和曹

1. 発明の名称

焦電電流の増加方法

2. 特許請求の範囲

ピニリデン系重合体中に光吸収熱変換効率を 向上させる色素を分散あるいは混合させて、光 照射時に検出される焦電電流を増加する方法。

3. 発明の詳細な説明

[技術分野]

本発明はビニリデン系重合体(以下単に PVD系重合体と称する)中に色素を分散、混 合させることにより焦電電流を増加させる方法 に関するものである。

[従来技術]

PVD系重合体の強誘電性を利用してこれを 記録暦とした光メモリー等のデバイスは公知で あり、またこの重合体の協電性を利用して光メ モリ記録層から記録を読み出すことも知られて いる。そして、PVD系重合体の焦電性に関す る文献・公祖等も過去に数多く報じられている。 しかしながら現状ではPVD系量合体(特に弗 化ピニリデン及び三弗化エチレン共重合体)単 独膜のLD光波長付近の光吸収熱変換効率は極 増に低いために、光照射による焦電電流の検出 は非常に困難であり、そのため高いパワーのレ ーザーを使用せねばならず、実用性及び生産性 の面で西題があった。

[目的]

本発明は、強誘電性デバイスにおけるPVD 系型合体の光吸収熱変換効率を向上させて、み かけの焦電率性能指数を向上させると共に、出 現する焦電電流を増加することを目的とするも のである。

[構成]

本発明者は、従来より上記課題解決のため研 究を重ねてきたが、PVD系型合体に色素を添 加することにより解決し得ることを見出し、本 発明を完成するに至った。

すなわち、本発明はピニリデン系重合体が現 す焦電効果において、該重合体中に光吸収熱変

特開昭64-16853 (2)

換効率を向上させる色素を分散あるいは混合させることにより検出される塩電電流を増加する方法である。

本発明において使用されているPVD系量合 体には種々の化合物が報告されているが、強誘 **電性を有して分極処理を施した場合に矩形に近** いヒステリシスを示すようなものが望ましく、 例えばポリ弗化ピニリデン、ポリシアン化ピニ リデン、弗化ビニリデンを50重量%以上含む弗 化ビニリデン共型合体、たとえば、弗化ビニリ デン及び三弗化エチレン共量合体、弗化ビニリ デン及び四弗化エチレン共量合体、弗化ピニリ デン及び弗化ビニル共重合体、弗化ビニリデン、 四弗化エチレン及び六弗化プロピレン三成分共 **重合体、あるいはシアン化ピニリデン及び酢酸** ピニル共量合体等が挙げられるが、この中でも 弗化ピニリデン及び三弗化エチレン共型合体 [以下P(VDF-TrFE)と略す]が好ま しい。

しかしながら、PVD系型合体膜は一般に光

にも半導体レーザー(LD)が最適と考えられる。LD光の照射方向は上部・下部何れの電極関からでも構わないが、その際に少なくとも光源の電極は照射光に対して透明であることが望ましい。

PVD系重合体中に添加する色素には該 PVD系重合体の強誘電性を妨げぬように以下 の特性が適宜要求される。

- 1) 照射光、特に半導体レーザー光波長付近に、吸収を持つこと
- 2) 導電性が低いこと
- 3) 熱的に安定であること

特に 1の条件を満たすものであることが望ましい。このような化合物としては、例えば、シアニン系色素、スクワリリウム系色素、メチン系色素、ナフトキノン系色素、キノンイミン系色素、アソ系色素、フタロシアニン系色素、 1,2-ジチオール系金属鎖体色素等が挙げられる。

以下実施例によって本発明を具体的に説明す

透過性が高く、光照射によるその焦電電流を検 出する際には、高出力のレーザー光等を必要と し、実用化に際して大きな問題となっていた。 本発明者等は該光メモリーの記録層を形成する PVD系建合体層中に分散しさらに照射光に対 して吸収を持つ染調料を見出し、該PVD系重 合体膜の光吸収効率を改善することにより検出 される焦電電流を増加する方法を確立すること に成功した。

PVD系理合体膜を製膜する方法としては浸潤コーティング、スプレーコーティング、スピナーコーティング、プレードコーティング等のでである。この中でも浸漉コーティングやスピナーコーティング、ローラーコーティングによるものが該PVD系重合体膜を均一な膜厚に形成する上に、超薄膜が得られる点からも好ましい。

光照射によって加熱することにより焦電電流 を検出する場合、照射光源は量産性及び価格的

るが、本発明はこれら実施例にのみ限定されるものではない。なお本実施例中で採用されている「みかけの性能指数」について説明する。本来焦電率性能指数とは下式で示されるように加えた熱優に対する分極量の変化で表される。

Py=<u>分極理</u>加えた熱量

しかしながら、現在のサンプルでは照射された光をすべて熱に変換している訳ではないので、 実際の性能指数よりは若干小さい値をとるが、 相対的な指数として比較する場合には十分に信 類し得る数値である。

比較例

厚さ的 1mmのITO 蒸着ガラス上に、スピンコート法によりP(VDFーTrFE)膜を厚さ 1μm で塗布して、さらに上部常極としてアルミニウムを蒸着した後に該P(VDFーTrFE)膜に 100Vの電圧をかけてポーリンク処理を施した。光強度 0.16mW、周波数10kllz でチョッピングしたLD光をP(VDF

ーTFF) 膜のポーリング処理をした部分に 照射して智恒間に生じる焦電電流を計測したと ころその電流値は $1 m n^2$ 当り0.3 p A でありその 性能指数は 1.0×10^{-4} ($C \cdot n / J$)であった。 実施例 1

P(VDF-TrFE)溶液中に下記式で示される 5wt%のシアニン色素を分散して、厚さ 1mmの I T O 蒸替ガラス上に、スピンコート法により厚さ 1μm で塗布してさらに上部電極としてアルミニウムを蒸替した後に該P(VDF-TrFE)膜に 100 Vの電圧をかけてポーリング処理を施した。比較例と同様の方法により、は電電流の測定から性能指数の測定を行ったところ観測された焦電電流は3pA/mm² であり、性能指数は 1.0×10 - □ (C・m/J)に達することが判明した。

実施例4

)

ポリエチレン樹脂表面にスパッタリング法によりITO透明電極を形成した。下記式色素をれる 5wt%のトリフェニルアミン系色素をP(VDF-TrFE)溶液電極基板上に関係した。以下では、2μmのP(VDF-TrFE)色素でサントでは、2μmのP(VDF-TrFE)色素でサントでは、2μmのP(VDF-TrFE)色素でサントでは、2μmのP(VDF-TrFE)をでは、2μmのP(VDF-TrFE)をでは、2μmのP(VDF-TrFE)をでは、2μmのP(VDF-TrFE)をでは、2μmのP(VDF-TrFE)をでは、2μmのP(VDF-TrFE)をでは、2μmのP(VDF-TrFE)をでは、2μmのP(VDF-TrFE)をでは、2μmのP(VDF-TrFE)をでは、2μmのP(VDF-TrFE)をでは、2μmのP(VDF-TrFE)をでは、2μmのP(VDF-TrFE)をでは、2μmのP(VDF-TrFE)をでは、2μmのP(VDF-TrFE)をでは、2μmのP(VDF-TrFE)をでは、2μmのP(VDF-TrFE)をでは、2μmのP(VDF-TrFE)をできませば、2μmのP(VDF-TrFE)をでは、2μmのP(VDF-TrFE)をできませば、2μmのP(VDF-TrFE)をできませが、2μmのP(VDF-TrFE)をできませが、2μmのP(VDF-TrFE)をできませが、2μmのP(VDF-TrFE)をできませが、2μmのP(VDF-TrFE)をできませが、2μmのP(VDF-TrFE)をできませが、2μmのP(VDF-TrFE)をで

実施例2

P(VDF-TrFE) 溶液中に下記式で示される 3Wt%の金属錯体系色素を分散して、実施例 1 と四様に厚さ 1MMの $ITO がラス上に厚さ <math>0.5\mu$ M にスピンコート膜を作製して、さらに実施例 1 と同様の方法で性能指数を評価したところ $1.5pA/MM^2$ の電流が観測され性能指数は 5.0×10^{-14} ($C \cdot M/J$)であった。

$$\begin{array}{c|c} & & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\$$

灾施例3

下記式で表される 1wt%の金属錯体系色素をP(VDF-TrFE)溶液中に分散した後に、ITOガラス基板上にP(VDF-TrFE)色素添加膜を浸渍コート法により厚さ 1μm で作製した。上記と同様な評価をしたところ 0.9pA/mm² の焦電電流が観測されてその性能指数は 3.0×10 - μ (C・m/J)であった。

[効果]

以上の説明から明らかなように、本発明の構成によれば、PVD系重合体膜中に色素を分散、混合することにより該重合体の光吸収熱変換効率を向上せしめ、従来検出が困難であった光照射時の焦電電流を増加することができた。また、この型合体膜は強誘電性高分子光メモリー、光センサー、焦電センサー、ディスプレイ等に有用である。

特許出類人 理 化 学 研 究 所 株式会社リ コ ー 代理人 弁理士 小 松 秀 岳 代理人 弁理士 旭 宏 代理人 弁理士 加々美 紀雄